

<u>VALORES MÁXIMOS ABSOLUTOS</u>(T_{amb}=25°C)

- EMISSOR		
V _R (tensão reversa)	6	\mathbf{V}
I _F (corrente direta)	60	mA
- DETETOR		
V _{CEO} (tensão coletor-emissor)	30	\mathbf{V}
V _{ECO} (tensão emissor-coletor)	6	\mathbf{V}
IC (corrente de coletor)	70	mA
P _D (potência de dissipação)	100	\mathbf{mW}
- CHAVE OPTOELETRÔNICA		
T _{stg} (temperatura de armazenagem)	-25 a +100	$^{\mathrm{o}}\mathrm{C}$
Top (temperatura de operação)	-20 a + 80	$^{\mathrm{o}}\mathrm{C}$
Top (temperatura de operação) Tsd (temperatura de soldagem)(t=5s)	250	oC

<u>CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS</u>(T_{amb}=25°C)

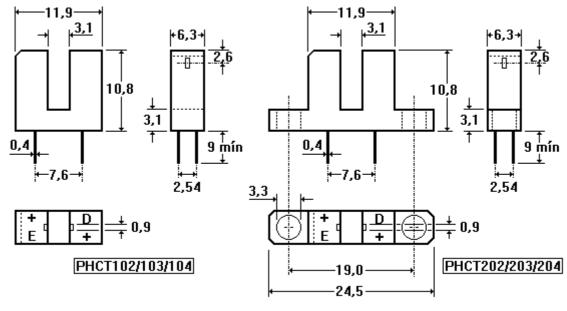
	(cond.teste)	<u>mín</u>	<u>típ</u>	<u>máx</u>	<u>unid.</u>
- EMISSOR				· 	
V _F (tensão direta)	$(I_F=30mA)$		1,2	1,5	\mathbf{V}
I _R (corrente reversa de fuga) - DETETOR	$(V_R=4V)$			10	μΑ
I _{CEO} (fuga coletor-emissor) (V _C - CHAVE OPTOELETRÔNICA				100	nA
CTR (taxa transf.corr.) (I _F =20	$mA,V_{CE}=5V$				
- F	PHCT102/202	20		40	%
F	PHCT103/203	10		70	%
I	PHCT104/204	50		100	%

CARACTERÍSTICAS DE CHAVEAMENTO

 $(I_C=2mA,V_{CE}=5V,R_L=100 \Omega)$

$t_{\mathbf{r}}$	(tempo de subida)	5	μs
$t_{\mathbf{f}}$	(tempo de descida)	5	μs

<u>DIMENSÕES FÍSICAS</u>(em mm)



TOLERÂNCIAS: ±0,1mm